

SOT89 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 4 – JUNE 1996



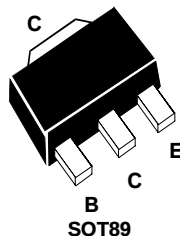
BST39

FEATURES

- * Fast Switching
- * High h_{FE} .

COMPLEMENTARY TYPE – BST16

PARTMAKING DETAIL – AT1



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	350	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	1	A
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-65 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	400		V	$I_C=10\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	350		V	$I_C=1mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E=10\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		20	nA	$V_{CB}=300V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.5	V	$I_C=50mA, I_B=4mA$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.3	V	$I_C=50mA, I_B=4mA$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	40			$I_C=20mA, V_{CE}=10V^*$
Output Capacitance	C_{obo}		2	pF	$V_{CB}=10V, f=1MHz$
Input Capacitance	C_{ibo}		20	pF	$V_{EB}=10V, f=1MHz$
Transition Frequency	f_T	70		MHz	$I_C=10mA, V_{CE}=10V, f=5MHz$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$
For typical characteristics graphs see FMMT458 datasheet.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9